

Федеральное государственное автономное научное учреждение
Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники
имени В.Г. Мокерова Российской академии наук

П Р И К А З № 91-00

г. Москва

«28» июля 2019 г.

[О создании Центра коллективного пользования научным, технологическим и измерительным оборудованием на базе Федерального государственного автономного научного учреждения Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники имени В.Г. Мокерова Российской академии наук]

П Р И К А З Ы В А Ю

С целью предоставления возможности научным и образовательным учреждениям, промышленным предприятиям и организациям, а также предприятиям малого бизнеса использования в режиме коллективного пользования уникального дорогостоящего оборудования и приборов для научно-методического и приборного обеспечения НИР и НИОКР для освоения миллиметрового и микроволнового диапазонов длин волн (от 1 ГГц до 5 ТГц в частотном эквиваленте), создания новых образовательных технологий, а также научно-исследовательских и образовательных методик.

1. С 1 июля 2019 года создать под моим руководством Центр коллективного пользования научным, технологическим и измерительным оборудованием на базе Федерального государственного автономного научного учреждения Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники имени В.Г. Мокерова Российской академии наук (ЦКП ИСВЧПЭ) на базе следующих лабораторий:

101 Лаборатория исследования процессов формирования низко-размерных электронных систем в наногетероструктурах соединений A_3B_5 ;

102 Лаборатория исследования процессов электронной литографии и формирования сверхкороткоканальных нанометровых- транзисторов;

103 Лаборатория исследования и разработки МЛЭ технологии нано-гетероструктурных квантовых ям и «мощных» СВЧ-транзисторов на их основе;

104 Лаборатория исследований и разработок методов моделирования и проектирования нано-гетероструктурных СВЧ- транзисторов и МИС и исследования их характеристик в см- и мм-диапазонах;

105 Лаборатория фундаментальных исследований низко-размерных электронных систем в нано-гетероструктурах полупроводниковых соединений A_3B_5 ;

106 Лаборатория исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, малощумящих и мощных наногетероструктурных СВЧ- транзисторов и МИС на их основе;

2. Утвердить Положение о Центре коллективного пользования научным, технологическим и измерительным оборудованием на базе Федерального государственного автономного научного учреждения Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники имени В.Г. Мокерова Российской академии наук (ЦКП ИСВЧПЭ) (Приложение 1) и Регламент предоставления услуг Центром коллективного пользования на базе Федерального государственного автономного научного учреждения Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники имени В.Г. Мокерова Российской академии наук (ЦКП ИСВЧПЭ) (Приложение 2).

3. Перечень оборудования Центра коллективного пользования Федерального государственного автономного научного учреждения Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники имени В.Г. Мокерова Российской академии наук (ЦКП ИСВЧПЭ):

- Установка молекулярно-лучевой эпитаксии RIBER 32P;
- Установка низкотемпературного плазмохимического осаждения диэлектрических слоев Plasmalab-100-ICP 180 фирмы Oxford Instruments;
- Установка низкоэнергетического плазменного травления материалов SI-500 ICP фирмы Sentech Instruments;
- Установка ВИМС (Вторичная ионная масс-спектрокопия) CAMECA IMS 4F;
- Установка плазменной обработки пластин Glen 1000P;
- Установка прецизионной контактной фотолитографии SUSS MJB4 IR (i-, g-, h-, line UV и DUV ($\lambda=200-250$ нм.));
- Установка электронно-лучевой нанолитографии высокого разрешения Voyager (Raith GmbH, 2014).

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по научной работе Д.С. Пономарева.

Директор ИСВЧПЭ РАН,
доктор технических наук

С.А. Гамкrelидзе

должность

подпись

расшифровка подписи

С приказом ознакомлен:

Заместитель директора на научной
работе

Д.С. Пономарев

«28» 06 2019 г.